
	<h2>SI8401DB-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8401DB-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8401DB-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 50825 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8401DB-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50825 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.6A (Ta) 1.47W (Ta) Surface Mount 4-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI8401DB-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI8401DB-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8401DB-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8401DB-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8401DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8401DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8402AB-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC</p>	 <p>SI8402AB-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC</p>
 <p>SI8402DB-T1 VISHAY SI8402DB-T1 VISHAY</p>	 <p>SI8401DB-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8402DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.3A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8401DB-T1 SILICON SI8401DB-T1 SILICON</p>

heiße Teile

Mehr

SI8234-B-IS	SI8234AB-C-IS1	SI8234AD-C-ISR	SI8235BB-C-IS	SI8235BD-D-ISR
SI8236BB-C-IM	SI8238AD-D-ISR	SI8252-IMR	SI8261AAC-C-IS	SI8261ABD-C-IS
SI8261ACC-C-IS	SI8261BAC-C-IPR	SI8261BAC-C-IS	SI8261BAD-C-IS	SI8261BBC-C-IS
SI8261BBD-C-IS	SI8261BCC-C-IP	SI8261BCC-C-IS	SI8261BCD-C-IS	SI8388P-IU
SI8400AA-B-IS	SI8400AB-B-ISR	SI8401DB-T1	SI8401DB-T1-E1	SI8401DB-T1-E1
SI8401DB-T1-E3	SI8402DB-T1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1.
SI8402DB-T1-E3	SI8404DB-T1-E1	SI8404DB-T1-E1	SI8405DB	SI8405DB-T1
SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E3	SI8405DB-T1-E3	SI8409DB-T1
SI8409DB-T1-E1	SI8409DB-T1-E1	SI8410AB	SI8410BB-D-ISR	SI8410BB-I-DS
SI8413DB-T1-E1	SI8413DB-T1-E1	SI8415DB-T1	SI8415DB-T1-E1	SI8415DB-T1-E1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited